



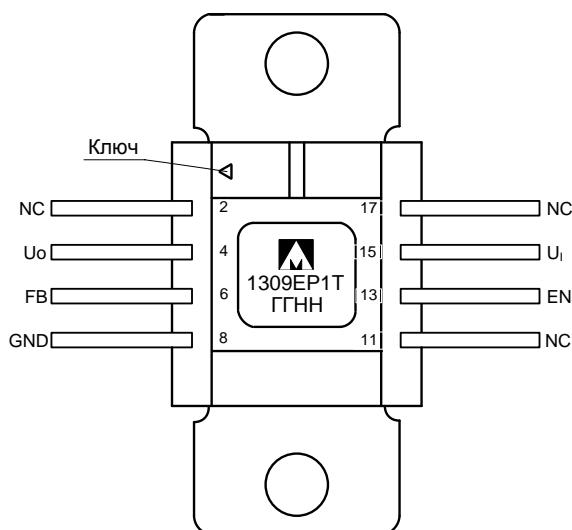
Стабилизатор напряжения фиксированный положительной полярности 1309EH1.2T, 1309EH1.8T, 1309EH2.5T, 1309EH3.3T, K1309EH1.2T, K1309EH1.8T, K1309EH2.5T, K1309EH3.3T, K1309EH1.2TK, K1309EH1.8TK, K1309EH2.5TK, K1309EH3.3TK;

Стабилизатор напряжения регулируемый положительной полярности 1309EP1T, K1309EP1T, K1309EP1TK

Основные параметры микросхемы

- Диапазон входного напряжения микросхем:

1309EH1.2T	от 2,0 до 5,5 В;
1309EH1.8T	от 2,6 до 5,5 В;
1309EH2.5T	от 3,3 до 5,5 В;
1309EH3.3T	от 4,1 до 5,5 В;
1309EP1T	от 2,0 до 5,5 В.
- Падение напряжение на регулирующем элементе (DropOut voltage) = 800 мВ при токе 2 А;
- Регулируемое выходное напряжение от 1,0 до 4,5 В для микросхемы 1309EP1T;
- Фиксированное выходное напряжение от 1,2 до 3,3 В для микросхем 1309EH1.2T, 1309EH1.8T, 1309EH2.5T, 1309EH3.3T;
- Защита от тока короткого замыкания и перегрева;
- Разрешающий вывод;
- Ток потребления в состоянии «Выключено» не более 50 мкА;
- Низкий обратный ток утечки (между выходом и входом);
- Рабочий диапазон температур:



ГГ – год выпуска

НН – неделя выпуска

Тип корпуса:

- 8-выводной металлокерамический корпус 4116.8-3

Обозначение	Диапазон
1309EH1.2T	минус 60 – 85 °C
1309EH1.8T	минус 60 – 85 °C
1309EH2.5T	минус 60 – 85 °C
1309EH3.3T	минус 60 – 85 °C
1309EP1T	минус 60 – 85 °C
K1309EH1.2T	минус 60 – 85 °C
K1309EH1.8T	минус 60 – 85 °C
K1309EH2.5T	минус 60 – 85 °C
K1309EH3.3T	минус 60 – 85 °C
K1309EP1T	минус 60 – 85 °C
K1309EH1.2TK	0 – 70 °C
K1309EH1.8TK	0 – 70 °C
K1309EH2.5TK	0 – 70 °C
K1309EH3.3TK	0 – 70 °C
K1309EP1TK	0 – 70 °C

Общее описание и области применения микросхемы

Микросхема 1309EP1T представляет собой стабилизатор напряжения регулируемый положительной полярности, созданный для применения в устройствах, требующих сверхнизкого входного напряжения и сверхнизкого падения напряжения на регулирующем элементе, для токов до 2 А.

Микросхема работает при входных напряжениях более 2,0 В, с программируемым выходным напряжением от 1,0 В. Особенностью микросхемы 1309EP1T является ультранизкое падение напряжения на регулируемом элементе, что идеально подходит для устройств, в которых значение выходного напряжения очень близко к входному напряжению. Кроме того, у микросхемы 1309EP1T есть разрешающий вывод, предназначенный для выключения микросхемы и уменьшения потребления тока.

Микросхема 1309EP1T устойчива к изменениям входного напряжения, выходного тока и температур. Значения выходного напряжения устанавливаются с помощью внешнего резистивного делителя.

Микросхемы 1309EH1.2T, 1309EH1.8T, 1309EH2.5T, 1309EH3.3T (далее по тексту 1309EHx.xT) представляют собой стабилизаторы напряжения фиксированной положительной полярности с выходным номинальным напряжением от 1,2 до 3,3 В соответственно названию микросхем. Входное напряжение микросхемы от 2,0 до 5,5 В (нижняя граница зависит от выходного напряжения типономинала). По остальным параметрам Микросхемы 1309EHx.xT аналогичны 1309EP1T.

Области применения микросхем:

- Сетевые платы;
- Материнские/периферийные платы;
- Промышленные устройства;
- Устройства беспроводной связи;
- Декодеры каналов кабельного телевидения;
- Медицинское оборудование;
- Ноутбуки;
- Устройства, питающиеся от батареи.

Описание выводов

Таблица 1 – Описание выводов микросхемы

Обозначение вывода	Номер вывода	Назначение вывода
U _o	4	Выход напряжения
FB	6	Вход обратной связи
EN	13	Вход разрешения работы: <0> – отключено; <1> – работа
U _i	15	Вход напряжения
GND	8	Общий
NC	2, 11, 17	Не используются

Структурная блок-схема микросхемы

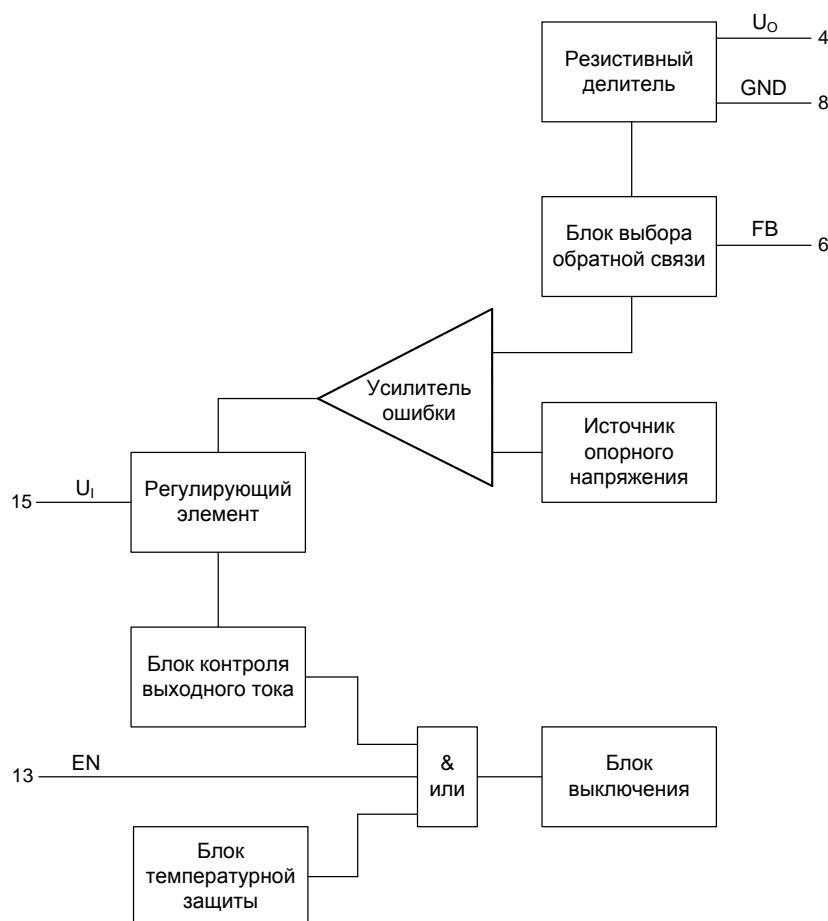


Рисунок 1 – Структурная блок-схема микросхем

Указания по применению и эксплуатации

При ремонте аппаратуры и измерении параметров микросхем замену микросхем необходимо проводить только при отключенных источниках питания.

Инструмент для пайки (сварки) и монтажа не должен иметь потенциал, превышающий 0,3 В относительно шины "Общий".

Запрещается подведение каких-либо электрических сигналов (в том числе шин "Питание" и "Общий") к выводам микросхем, не используемым согласно схеме электрической.

Типовые схемы включения микросхем приведены на Рисуках 2, 3.

Крышка корпуса электрически соединена с монтажной площадкой, выводом 8 и радиатором корпуса.

Описание функционирования микросхемы

Необходимая величина выходного напряжения регулятора обеспечивается с помощью усилителя ошибки, путем сравнения опорного напряжения с пропорцией от выходного напряжения (соотношение пропорции задается резистивным делителем). При несовпадении этих двух величин усилитель ошибки, в зависимости от полярности их разности, меняет напряжение затвора выходного силового транзистора. Таким образом, значение тока нагрузки будет таким, при котором отклонение выходного напряжения от номинального будет минимальным.

В микросхеме 1309EP1T используется внешний резистивный делитель, и с опорным напряжением сравнивается напряжение вывода FB. В микросхемах 1309EHx.xT присутствует внутренний делитель, для корректной работы которого вывод FB должен быть соединен с выводом Uo. В этом случае, за счет блока запоминающего устройства, состояние которого соответствует типономиалу микросхемы, на усилитель ошибки подается напряжение определенного узла делителя. При этом выходное напряжение микросхемы будет соответствовать номинальному.

При срабатывании датчиков превышения допустимых значений тока или температуры выходной транзистор закрывается.

Установление напряжения вывода EN равным 0 В обеспечивает отключение микросхемы, при котором ее ток потребления не превышает 50 мА.

Выбор внешних элементов

Входной конденсатор: чтобы предотвратить падение входного напряжения ниже 2,0 В, необходимо подключить конденсатор емкостью 10 мкФ к выводу входного напряжения. Для фильтрации высокочастотных помех необходимо поместить керамический конденсатор емкостью 1 мкФ в непосредственной близости от вывода U_i. Кроме того, в результате данных мер уменьшаются флюктуации входного напряжения при изменении выходного напряжения. При необходимости может быть добавлена дополнительная емкость.

Выходной конденсатор: рекомендуется подключить к выводу выходного напряжения сглаживающую емкость номиналом 10 мкФ. Использование нескольких низкоемкостных керамических конденсаторов, подключенных в параллель для достижения требуемой суммарной емкости, не вызывает ухудшения стабильности. Несмотря на то, что микросхема 1309EP1T предусматривает использование керамических выходных конденсаторов, запас устойчивости устройства к значениям эффективного последовательного сопротивления выходной емкости позволяет применять также и tantalовые конденсаторы.

Помехоустойчивость: в условиях сильных электрических помех следует подключить керамический конденсатор номиналом 0,1 мкФ между выводами U_i и GND, а также U_o и GND максимально близко к выводам устройства.

Выбор выходного напряжения для ИМС 1309EP1: для задания выходного напряжения необходимо использовать внешний резистивный делитель, как показано на рисунок 2. Для обеспечения устойчивости и достижения требуемых характеристик необходимо использовать резисторы с погрешностью 0,1%:

$$R2 \approx 10 \text{ кОм} \text{ (рекомендованное значение)}$$

$$R1 = \frac{R2 * (U_o - 0.5)}{0.5}$$

Разрешающий вывод: при понижении напряжения на выводе EN до 0,4 В и ниже регулятор отключается, снижая ток потребления. Для стабильной работы вывод EN должен соединяться с выводом U_I непосредственно или через подтягивающий резистор.

Температурные условия

Условия эксплуатации при нагреве определяются допустимой температурой корпуса равной 85 °C.

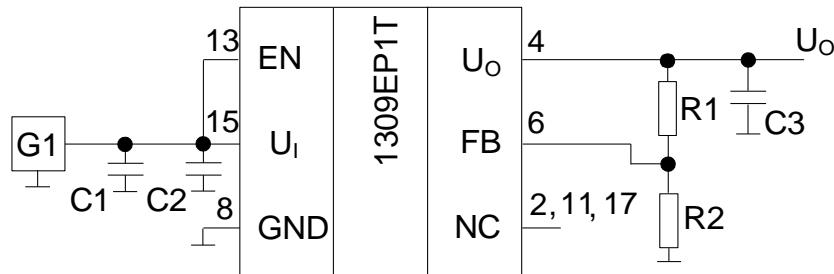
Нагрев корпуса зависит от температуры окружающей среды и мощности, рассеиваемой микросхемой.

Мощность, рассеиваемая на микросхеме 1309EP1T равна произведению выходного тока на разницу входного и выходного напряжений:

$$P = (U_I - U_O) * I_O = U_D * I_O$$

Максимальное входное напряжение, подаваемое на микросхему, необходимо выбирать с учетом условия, что предельная мощность, рассеиваемая на микросхеме не должна превышать предельно-допустимое значение 3 Вт.

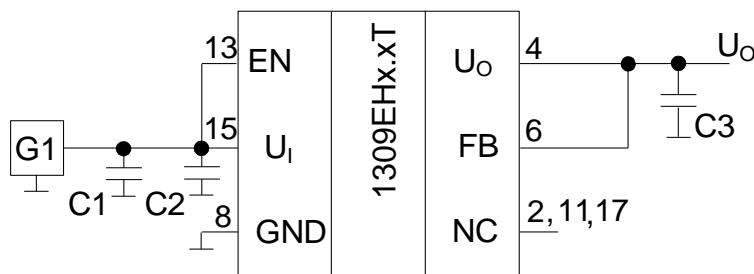
Типовые схемы включения микросхемы



$$U_o = \frac{0,5(R1 + R2)}{R2} \text{ В}$$

- 1309EP1 – включаемая микросхема;
- G1 – источник постоянного напряжения (2,0 – 5,5) В;
- R1, R2 – резисторы, $R1 = R2 \cdot (U_o - 0,5 \text{ В}) / 0,5 \text{ В}$;
 $R2 \approx 10 \text{ кОм}$ (рекомендуемое значение);
- C1 – C3 – конденсаторы, $C1 = 1 \text{ мкФ} \pm 10 \%$;
 $C2 = C3 = 10 \text{ мкФ} \pm 10 \%$;

**Рисунок 2 – Типовая схема включения микросхемы 1309EP1T
с внешним делителем**



- 1309EHx.xT – включаемая микросхема;
- G1 – источник постоянного напряжения (2,0 – 5,5) В;
- C1 – C3 – конденсаторы,
 $C1 = 1 \text{ мкФ} \pm 10 \%$;
 $C2 = C3 = 10 \text{ мкФ} \pm 10 \%$;

**Рисунок 3 – Типовая схема включения микросхемы 1309EHx.xT
с фиксированным выходным напряжением**

Предельные и предельно-допустимые режимы работы

Превышение параметров, указанных ниже, может привести к необратимому повреждению устройства или к неправильному его функционированию. Не предусмотрено функционирование микросхемы вне условий, указанных в разделе «Электрические параметры».

Таблица 2 – Предельно-допустимые и предельные режимы эксплуатации микросхем

Наименование параметра, единица измерения	Буквенное обозначение параметра	Норма параметра			
		Предельно- допустимый режим		Предельный режим	
		не менее	не более	не менее	не более
Входное напряжение, В 1309EH1.2T	U_I	2,0	5,5	–	6,0
		2,6	5,5	–	6,0
		3,3	5,5	–	6,0
		4,1	5,5	–	6,0
		U_O+U_D , но не менее 2 В	5,5	–	6,0
Напряжение высокого уровня на входе EN, В	U_{IH_EN}	1,6	U_I	–	$U_I + 0,3$
Напряжение низкого уровня на входе EN, В	U_{IL_EN}	0	0,4	– 0,3	–
Ток нагрузки, А	I_O	0,01	2,0	–	I_O_LIM
Рассеиваемая мощность, Вт при температуре корпуса +85 °C	P	–	3	–	4

Примечание – Не допускается одновременное воздействие нескольких предельных режимов.

Электрические параметры микросхемы

Таблица 3 – Электрические параметры микросхем при приёмке и поставке

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение параметра	Норма параметра		Температура, °C
		не менее	не более	
Выходное напряжение, В 1309EH1.2T	U_O	1,164	1,236	25,* 85,* – 60
1309EH1.8T		1,746	1,854	
1309EH2.5T		2,425	2,575	
1309EH3.3T		3,201	3,399	
1309EP1T		1,0	4,5	
Минимальная разность напряжения вход-выход, В	U_D	-	0,8	
Входной ток на выводе FB, мкА микросхема 1309EP1T	I_{FB}	-	10	
Ток потребления, мА	I_{CC}	-	3	
Ток потребления в состоянии «Выключено», мкА при: $U_{EN} = 0$ В, $U_O = 0$ В	I_{CCZ}	-	50	
Входной ток высокого уровня на выводе EN, мкА	I_{IH_EN}	-	10	
Входной ток низкого уровня на выводе EN, мкА	I_{IL_EN}	– 10	-	
Ток срабатывания защиты, А	I_{O_LIM}	2,5	4,5	
Нестабильность по напряжению, %/В	K_{UI}	-	1	
Нестабильность по току, %/А	K_{IO}	-	1	
Относительное отклонение выходного напряжения от установленного, % микросхема 1309EP1T	$\Delta_{ХОТК}$	– 3	3	
* Указана температура корпуса				

Типовые зависимости

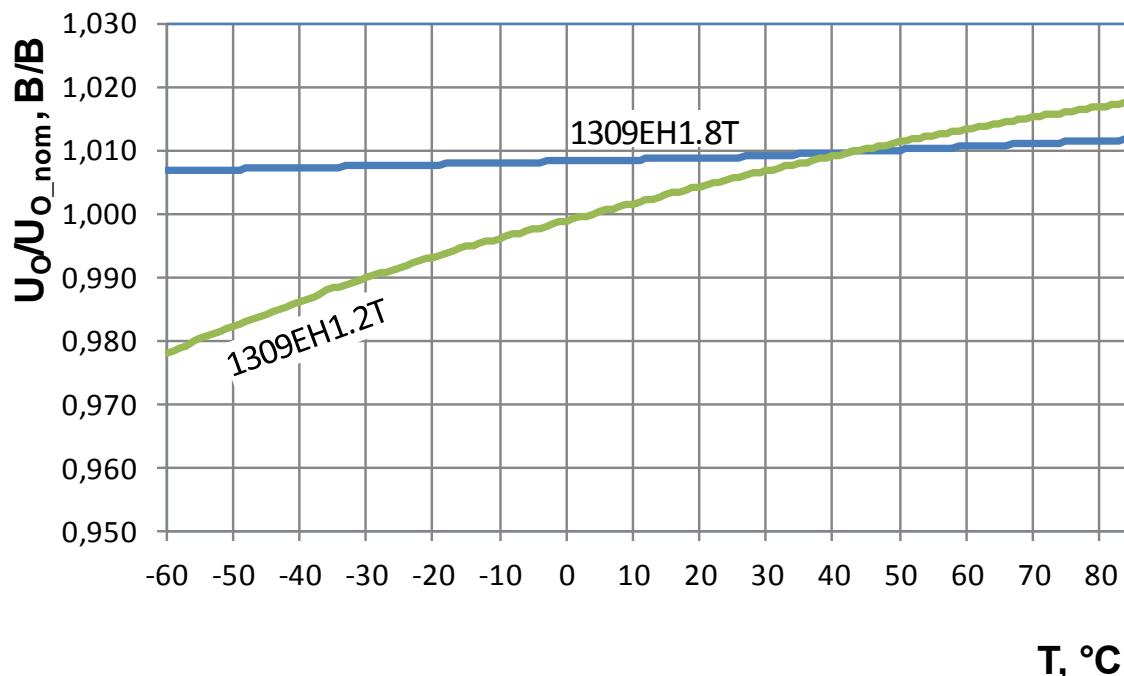


Рисунок 4 – Зависимость выходного напряжения U_O (приведенного к выходному напряжению номинальному U_{O_nom}) от температуры корпуса при $U_I = U_{I\ min} B$, $I_O = 10 \text{ mA}$

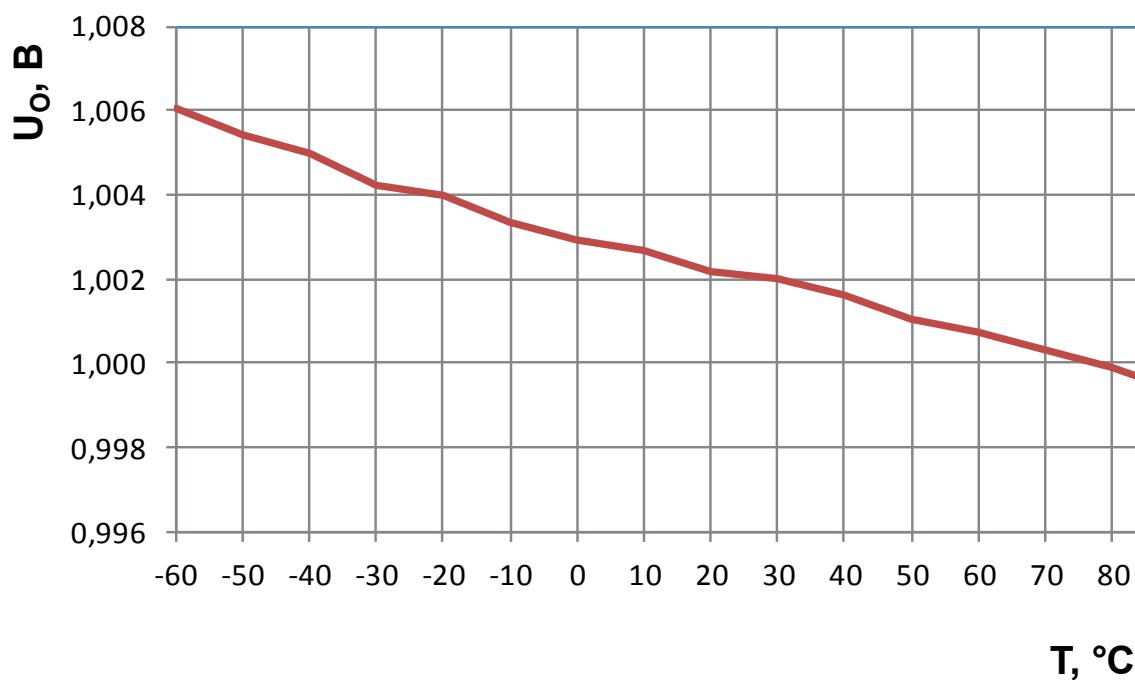


Рисунок 5 – Зависимость минимального выходного напряжения U_O микросхемы 1309EP1T от температуры корпуса при $U_I = 2 \text{ B}$, $I_O = 10 \text{ mA}$

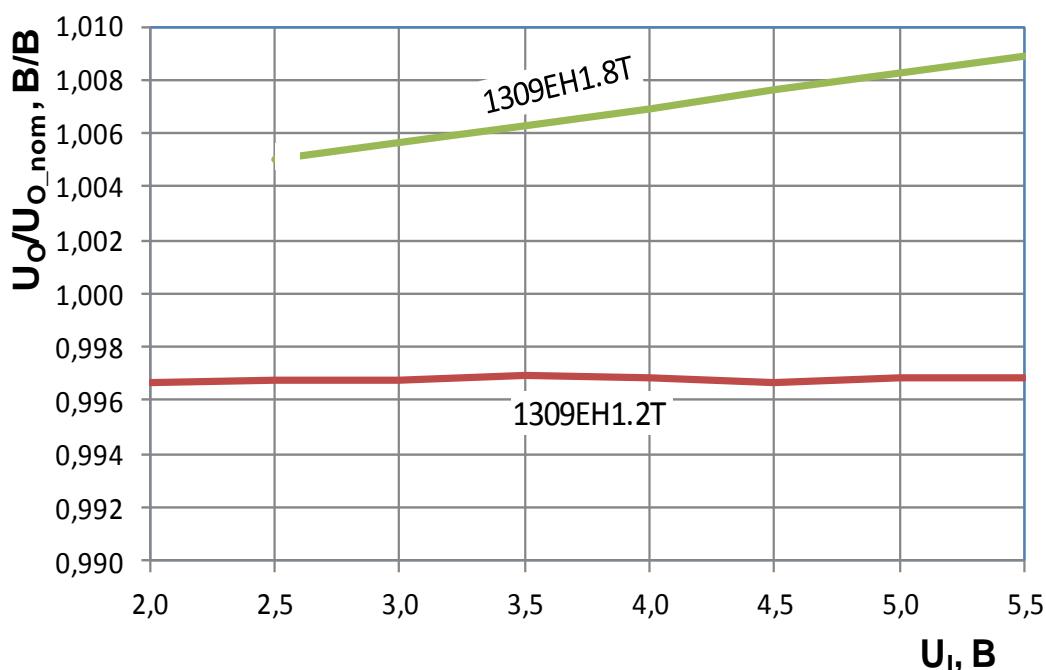


Рисунок 6 – Зависимость выходного напряжения U_O (приведенного к выходному напряжению номинальному U_{O_nom}) от входного напряжения при $I_O = 100$ мА, $T = 25$ °C

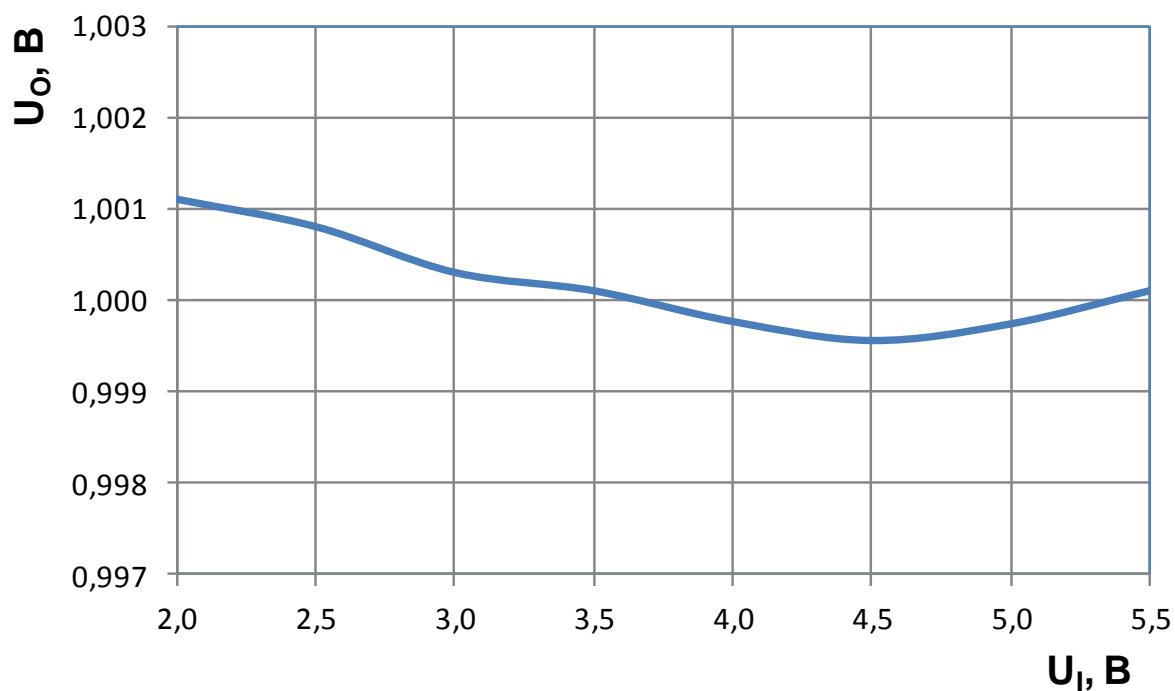


Рисунок 7 – Зависимость минимального выходного напряжения U_O микросхемы 1309EP1T от входного напряжения при $I_O = 100$ мА, $T = 25$ °C

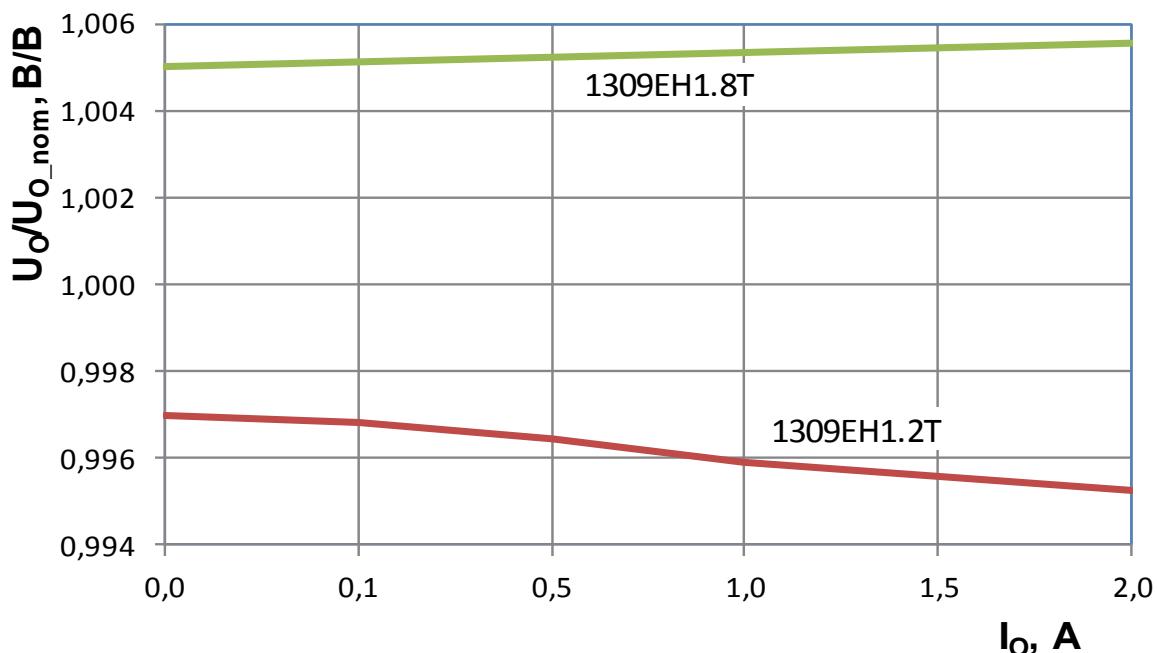


Рисунок 8 – Зависимость выходного напряжения U_o (приведенного к выходному напряжению номинальному U_{o_nom}) от тока нагрузки при $U_I = 2,8$ В для 1309EH1.2T и $U_I = 2,6$ В для 1309EH1.8T, $T = 25$ °C

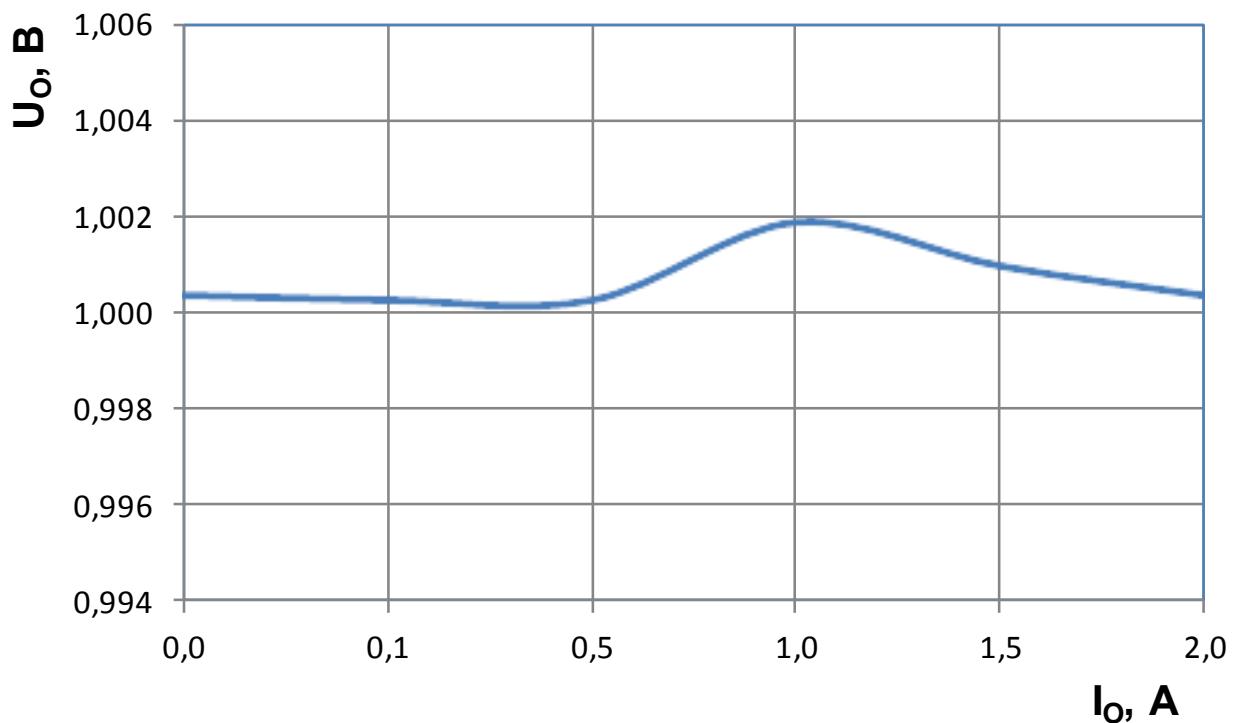


Рисунок 9 – Зависимость минимального выходного напряжения U_o микросхемы 1309EP1T от тока нагрузки при $U_I = 2,5$ В, $T = 25$ °C

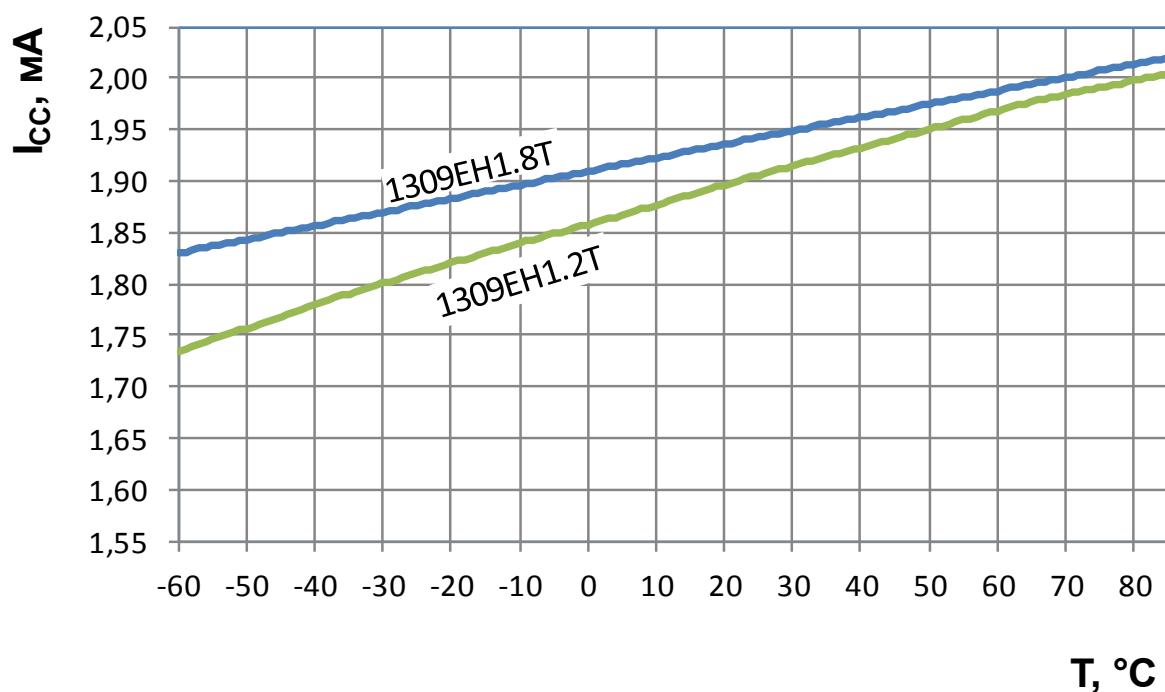


Рисунок 19 – Зависимость тока потребления I_{CC} от температуры
при $U_I = 5,5$ В, $I_O = 10$ мА

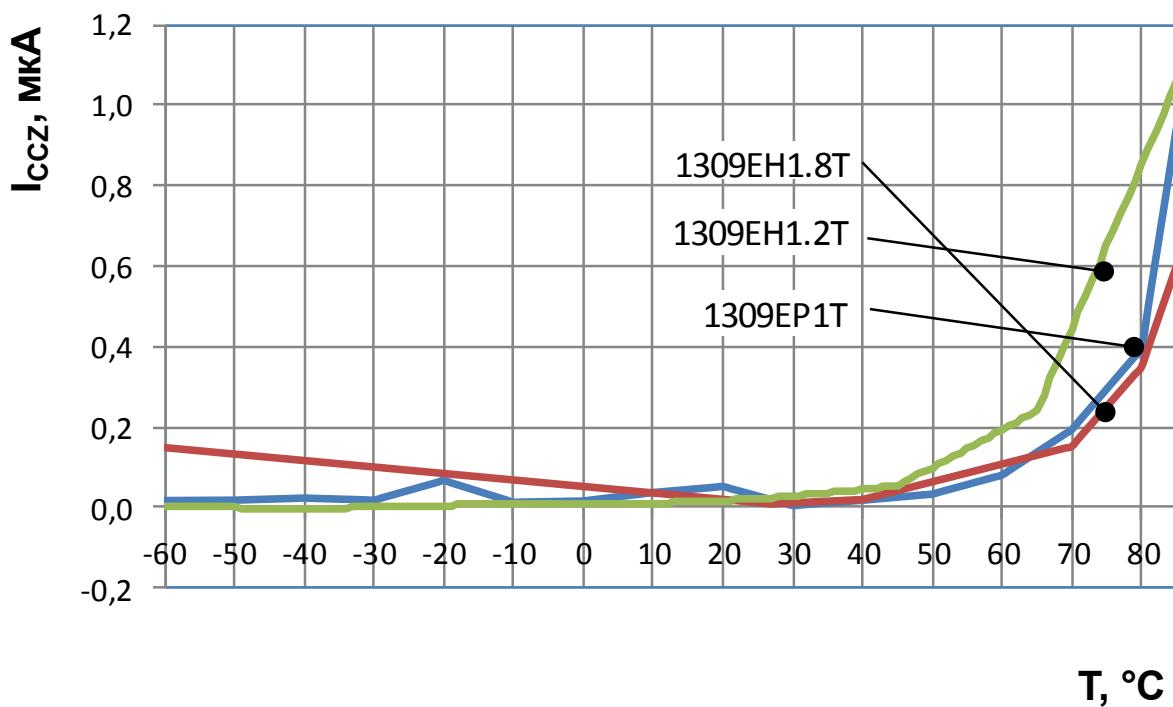


Рисунок 20 – Зависимость тока потребления в состоянии выключено I_{CCZ} от температуры корпуса

Габаритный чертеж микросхемы

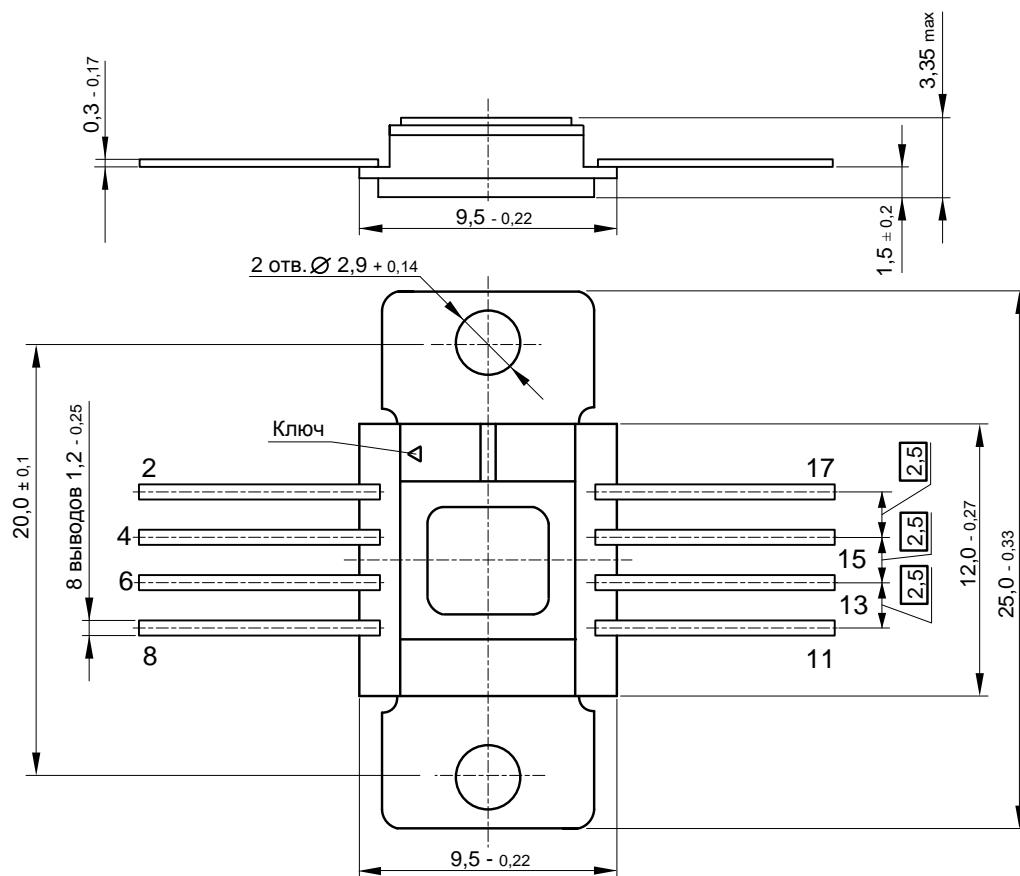


Рисунок 20 – Корпус 4116.8-3

Информация для заказа

Обозначение	Маркировка	Тип корпуса	Температурный диапазон
1309EH1.2T	EH1.2	4116.8-3	минус 60 – 85 °C
K1309EH1.2T	KEH1.2	4116.8-3	минус 60 – 85 °C
K1309EH1.2TK	KEH1.2•	4116.8-3	0 – 70 °C
1309EH1.8T	EH1.8	4116.8-3	минус 60 – 85 °C
K1309EH1.8T	KEH1.8	4116.8-3	минус 60 – 85 °C
K1309EH1.8TK	KEH1.8•	4116.8-3	0 – 70 °C
1309EH2.5T	EH2.5	4116.8-3	минус 60 – 85 °C
K1309EH2.5T	KEH2.5	4116.8-3	минус 60 – 85 °C
K1309EH2.5TK	KEH2.5•	4116.8-3	0 – 70 °C
1309EH3.3T	EH3.3	4116.8-3	минус 60 – 85 °C
K1309EH3.3T	KEH3.3	4116.8-3	минус 60 – 85 °C
K1309EH3.3TK	KEH3.3•	4116.8-3	0 – 70 °C
1309EP1T	EP1	4116.8-3	минус 60 – 85 °C
K1309EP1T	KEP1	4116.8-3	минус 60 – 85 °C
K1309EP1TK	KEP1•	4116.8-3	0 – 70 °C

Лист регистрации изменений

№ п/п	Дата	Версия	Краткое содержание изменения	№№ изменяемых листов	№№ новых листов
1	10.10.2008	1.2			
2	07.04.2010	1.3	Корректировка на основании планового пересмотра документации	1, 9	10
3	27.04.2010	1.4	Замена логотипа	1	
4	08.10.2010	1.5	Приведение в соответствие с ТЗ		
5	20.10.2010	1.6	Редактирование текста		
6	21.09.2012	1.7	Введение новых изделий 1309EH1.2T, 1309EH1.8T, 1309EH2.5T, 1309EH3.3T. Таблицы 2, 3 в соответствии с ТУ.		
7	05.10.2012	1.8.0	Приведение в соответствие с проектом ТУ	1-10	5
8	17.09.2013	1.9.0	Добавлено бескорпусное исполнение микросхемы.	1, 3, 11, 12	
9	23.10.2013	1.10.0	Приведено к единому варианту одозначения выводов. Откорректировано описание вывода EN	1, 3, 6	
10	04.02.14	1.10.1	Исправлена маркировка микросхем.	12	
11	08.09.2014	2.0.0	Приведение в соответствие с ТУ и КД	все	
12	20.10.2014	2.1.0	Корректировка раздела Описание функционирования микросхемы	5, 6	
13	02.02.2016	2.2.0	Исправлен рисунок 20 Исправлены опечатки в таблицах 7, 8	13 7, 8	
14	07.06.2016	2.3.0	Добавлен раздел «Указания по применению и эксплуатации»		4